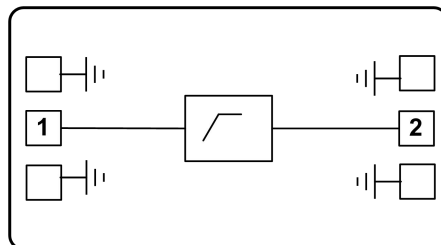




主要特点

通带频率: 30 – 50 GHz
通带损耗: ≤ 2.8 dB @ 30 GHz
阻带衰减: ≥ 40 dB @ 25 GHz
 ≥ 55 dB @ 21GHz
回波损耗: 15 dB
芯片尺寸: $1.24 \times 0.62 \times 0.1$ mm³

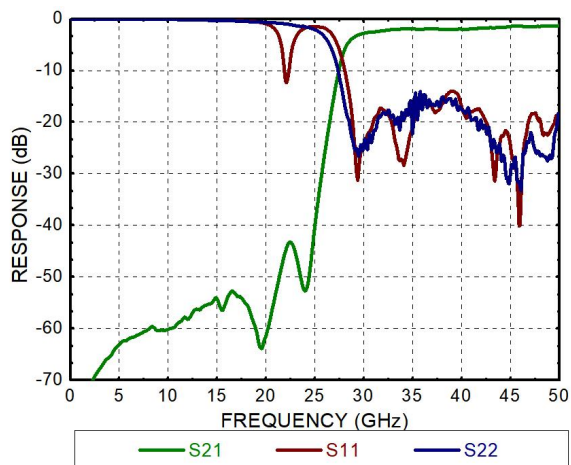
功能框图



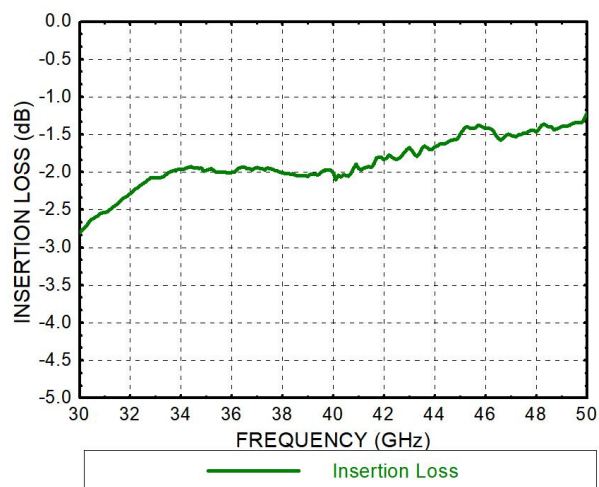
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	30 - 50			GHz
插入损耗		2.0		dB
阻带衰减 @25GHz		40		dB
阻带衰减 @21GHz		55		dB
回波损耗		15		dB

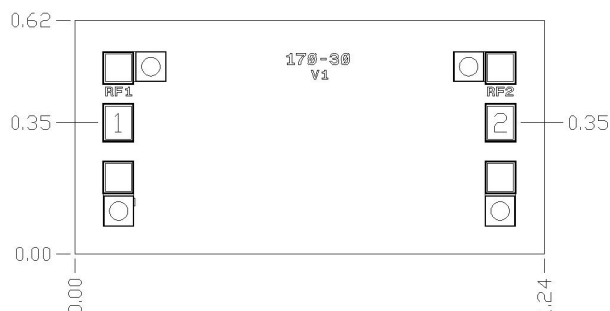
反射系数



插入损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C